

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分
 【発行日】平成20年2月7日 (2008.2.7)

【公開番号】特開2006-272756(P2006-272756A)
 【公開日】平成18年10月12日 (2006.10.12)
 【年通号数】公開・登録公報2006-040
 【出願番号】特願2005-95386(P2005-95386)
 【国際特許分類】

B 2 8 D 7/04 (2006.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 2 4 B 27/06 (2006.01)

【F I】

B 2 8 D 7/04

H 0 1 L 21/304 6 1 1 W

B 2 4 B 27/06 D

【手続補正書】

【提出日】平成19年12月17日 (2007.12.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体ブロックが接着剤により接着される第1の面を有するスライスベースを備え、前記スライスベースの前記第1の面が、前記半導体ブロックと接着される領域の端部に凹部を有することを特徴とする半導体ブロックの保持装置。

【請求項 2】

前記スライスベースの前記第1の面と前記半導体ブロックとの前記接着領域が四角形状を有し、前記スライスベースの前記凹部は、前記スライスベースの前記第1の面と前記半導体ブロックとの前記接着領域の対角線に沿って形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体ブロックの保持装置。

【請求項 3】

前記凹部は、前記スライスベースの前記半導体ブロックと接着される領域の中央部と外周部との間に形成されていることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の半導体ブロックの保持装置。

【請求項 4】

前記凹部は、前記接着領域に面した開口部の面積が、前記接着領域の 5 % 以上 10 % 以下であることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の半導体ブロックの保持装置。

【請求項 5】

前記凹部は、前記接着領域の外周部から中央部に向かって横断面の幅が狭くなるように変化することを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の半導体ブロックの保持装置。

【請求項 6】

前記スライスベースは、前記半導体ブロックより大きいことを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の半導体ブロックの保持装置。

【請求項 7】

前記凹部は、前記スライスベースの前記第1の面と前記半導体ブロックとの前記接着領域

の外周にさらに形成されていることを特徴とする請求項 6 に記載の半導体ブロックの保持装置。

【請求項 8】

前記凹部は溝状に形成されていることを特徴とする請求項 1 ～ 7 のいずれかに記載の半導体ブロックの保持装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0017】

本発明の半導体ブロックの保持装置は、半導体ブロックが接着剤により接着される第1の面を有するスライスベースを備え、前記スライスベースの前記第1の面が、前記半導体ブロックと接着される領域の端部に凹部を有することを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

本発明の半導体ブロックの保持装置は、前記スライスベースの前記第1の面と前記半導体ブロックとの前記接着領域が四角形状を有し、前記スライスベースの前記凹部は、前記スライスベースの前記第1の面と前記半導体ブロックとの前記接着領域の対角線に沿って形成されていることを特徴とする。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

本発明の半導体ブロックの保持装置は、前記凹部が前記スライスベースの前記半導体ブロックと接着される領域の中央部と外周部との間に形成されていることを特徴とする。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0020】

本発明の半導体ブロックの保持装置は、前記凹部が、前記スライスベースの前記半導体ブロックと接着される領域の中央部と外周部との間に形成されていることを特徴とする。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0021】

本発明の半導体ブロックの保持装置は、前記凹部が前記接着領域の外周部から中央部に向かって横断面の幅が狭くなるように変化することを特徴とする。

【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 2

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 2 2 】

本発明の半導体ブロックの保持装置は、前記スライススペースが、前記半導体ブロックより大きいことを特徴とする。

【手続補正 8】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 3

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 2 3 】

本発明の半導体ブロックの保持装置は、前記凹部は、前記スライススペースの前記第1の面と前記半導体ブロックとの前記接着領域の外周にさらに形成されていることを特徴とする。

°

【手続補正 9】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 4

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 2 4 】

本発明の半導体ブロックの保持装置は、前記凹部が溝状に形成されていることを特徴とする。

【手続補正 10】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 4 8

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 4 8 】

本発明に係る半導体ブロックの保持装置において、スライススペース3の接着面（第1の面）には、半導体ブロック1との接着領域で接着剤2が滞留する凹部を設けるようにした。接着剤2が滞留する凹部を設けるようにしたことで、余った接着剤がスライススペース短手方向、つまりワイヤーの進行方向からはみ出すことを抑制することができる。